⑲ 日本 国特許庁(JP)·

① 特 許 出 願 公 開

四公開特許公報(A)

昭61 - 121379

Mint Cl 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)6月9日

_H 01 S 3/101

6370-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

69発明の名称

レーザ出力変調方法及び装置

頭 昭59-242432 ②)特

29出 願 昭59(1984)11月19日

勿発 明者 迫 宏 伊勢原市桜台5丁目14-11 すみれ荘1号室

⑫発 明 者 鉿 木 正 弘 神奈川県中郡大磯町生沢316

木・村 砂発 明 考

小田原市建正寺160

正 雄

アマダ

⑪出 願 株式会社

伊勢原市石田200番地

砂代 理 弁理士 三好 保男 外1名

1. 発明の名称

レーザ出力変調方法及び装置

2. 特許請求の範囲

① 入射光軸を中心に回転自在に設けられたア リュスタウィンドウに直線備光されたレーザ光を プリュスタ角で入射し、前記プリュスタウィンド ウを回転させることによってこれを透過するレー ザ光の強度を変調させることを特徴とするレーザ 出力变調方法。

② 入射光軸を中心に回転自在に設けたプリュ スタウィンドウと、このブリュスタウィンドゥを 光軸の周りに所望角度回転させる回転手段と、前 記 ブリュスタウィンドウを透過した 藏線 牖 光のレ ーザ光を円偏光に変換する1/4被長板と、この 1/4波長板の回転角の調盤手段とを備えて成る レーザ出力変調装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

この発明は、レーザ発振器から出力された直線

. 偏光のレーザ光の出力を調整するレーザ出力変調 方法及び装置に関する。

[発明の技術的背景及びその問題点]

従来 一 般に レー ザ 加 工 機 で レー ザ 出 力 を 変 調 す る方法は電流値制御方式が主流であり、注入電力 を制御することによりレーザ発振器のレーサ出力 を変化させるようにしている。

しかしながらこのような従来のレーザ出力変調 方法では、レーザ発振器そのものの出力を変更す るものであるためレーザ発振器を常に一定の出力 で運転させたままそのレーザ出力を変化させると いったことができず、レーザ出力の安定した変調 を行うという点で問題があった。

[発明の目的]

この発明は、このような従来の問題点に鑑みて なされたものであって、レーザ発掘器出力は常に 一定に保ったまま、外部においてレーザ出力に変 調をかけ、所望の強さの安定したレーザ出力が得 られるレーザ出力変調方法及びその装置を提供す るものである。



この発明は、レーザ発振器から出力されてくる 直線偏光のレーザ光に対して発振器外部に設けら れたプリュスタウィンドウの方位角を変化させ、 その透過レーザ出力を制御することによりレーザ 出力を制御するものである。

すなわち、入射光性を中心に回転自在に設けられたプリュスタウィンドウに直線偏光されたレーザ光をプリュスタ角で入射し、前記プリュスタウィンドウを回転させることによってこれを選りるレーザ光の強度を変調させることを特徴とするレーザ出力変調方法、及び

入射光軸を中心に回転自在に設けたプリュスタウィンドウと、このプリュスタウィンドウを光軸の周りに所望角度回転させる回転手段と、前記プリュスタウィンドウを透過した直線偏光のレーザ光を円偏光に変換する1/4波長板と、この1/4波氏板の回転角の調整手段とを備えて成るレーザ出力変調装置である。

〔発明の変施器〕

によって垂直方向にその進路を変更して 1 / 4 波 長板 1 5 の入射光軸 C と一致させ、下方のワーク Wに対して築光レンズ 2 5 により集光しレーザ加 エを行なうのである。

こうした円偏光装置17を用いる理由は、透過レーザ光9は入射レーザ光3とは偏光方向が若干 異なるものの直線偏光のままであり、実際のレー ザ切断を考慮するときには円偏光切断が安定した 切断を行なえるためである。

上記実施例のレーザ出力変調装置を用いたレーザ出力変調方法の基本原理を更に詳疑する。第2回はプリュスタウィンドウの窓材として用いるのののでレーザ光が入射した時の反射光ののとの範囲でレーザ光が入射面に垂直ならの分ののででしている。グラフからののように、反射光中成分のエネルギ反射率を示している。グラフからのかなように、反射光中成分のエネルギ反射率が行った。この時の入射角のはプリュスタ角と呼ばれ、次式で決定される。

前記透過レーザ出力9はその進路を変更するための主反射級13によて90°垂直方向に変更される。そしてこの主反射級13の下方には1/4数長板15を有する円偏光装置17が光軸Cの円偏光を置17は、主反射級13から来る直線光に変換し、その円偏光を複数の反射級19、21、23

8 8 4 tan 1 n (n : 照折率) ……(1) 今、 Z n S e の場合 n ÷ 2 . 4 であるから、式(1) から θ B = 6 7 . 3 8 と決定される。従って、ブリュスタ 角にセットされたブリュスタウィンドウにレーザ光を入射させると、入射面に平行な P 成分はほとんど反射されることなく 透過し、入射面に垂直な S 成分は約 5 0 % 近く 反射されることになる。この結果が第 3 図にわかりやすく示されている。

以上のようなブリュスタウィンドウの特性を利用すれば、入射レーザ光の偏光方向は変化させず、ブリュスタウィンドウ7を有するレーザ出力変調装置5を2触のまわりに回転することによってレ



ーザ出力を変調することができる。

次に、そのレーザ出力がどの程度変調されるかを示す。一般的な直線優光が例えばZnSeのような誘導体DEに入別する際の反射及び透過の状態は第4図に示すようなものである。今、第4図において入射光、反射光、透過光の電場ベクトル(振幅)をそれぞれA。R。Dとする。このとき、それぞれの光を入射面に平行なP成分と垂直なS成分に分割すると次式が成り立つ。

$$A^2 = Ap^2 + As^2$$

$$R^2 = R p^2 + R s^2$$

--- (2)

 $D^{2} = D p^{2} + D s^{2}$

さらに、第5図に入射光AのP. S成分に分割 した例を示す。このとき、入射光Aの電腦ベクト ルの偏光方向と入射面に平行なP成分とのなす角 (方位角)をαとすると、次式が与えられる。

Ap - A cos a

$$As = Asin \alpha$$
 ... (3

ここで反射光尺にのみ注目して、反射光尺のエネルギ反射率(合成)を考える。反射光のエネル

ある。さらに入射直線偏光をブリュスタ角で入射させると、P成分のエネルギ反射率 | Rp / Ap | 1² = Oとなるので、(4)式は次式のように簡単な形をとる。

R² / A² = sin² α・ι R s / A s l² … (5) また、今求めた反射率R² / A² (= R E) と 透過総T E (= D² / A²) との間には、

(の式から求めた透過率下Eと、入射偏光の偏光 方向と入射面とのなす角(方位角)などの関係が 第6図に示されている。この第6図から、入射化 性 2に対してブリュスタウィンドウブを回転させ、 方位角なーの・から90、まで変化させると、透 過率下Eは100%から約50%まで単調に減少 することがわかる。この結果を第7図に対してブリ リュスタウィンドウを0、45、90、と回 ギ反射率はR2 / A2 であって、

$$\frac{RD^{2} + RS^{2}}{AD^{2} + AS^{2}}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} RD \end{vmatrix}^{2} + \begin{vmatrix} RS \end{vmatrix}^{2}}{AD} \begin{vmatrix} RS \end{vmatrix}^{2} + \begin{vmatrix} AS \end{vmatrix}^{2}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} RD \end{vmatrix}^{2} + \begin{vmatrix} RS \end{vmatrix}^{2} + \begin{vmatrix} AS \end{vmatrix}^{2}}{AD}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} RD \end{vmatrix}^{2} + \begin{vmatrix} RS \end{vmatrix}^{2} + \begin{vmatrix} AS \end{vmatrix}^{2}}{AD}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} RD \end{vmatrix}^{2} + \tan^{2}\alpha \cdot \begin{vmatrix} RS \end{vmatrix}^{2}}{AS}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} RD \end{vmatrix}^{2} + \tan^{2}\alpha \cdot \begin{vmatrix} RS \end{vmatrix}^{2}}{AS}$$

ご式(3) より A p = A cos α . A s = A sin α よって、

 $R^{2} / A^{2} = \sin^{2} \alpha \cdot i R s / A s |_{2} + \cos^{2} \alpha \cdot i R p / A p |_{1}^{2} \cdots (4)$

 $1 + \tan^2 \alpha = 1 / \cos^2 \alpha$

となる。この(4)式の意味は、反射光強度がその入 射觀線偏光の方位角と、P. S 成分それぞれのエ ネルギ反射率とによって決定されるということで

転させるならば、選過率 TE に $100\% \rightarrow 75\%$ $\rightarrow 50\%$ と変化を与えることができ、 ブリュスタウィンドウ 7 を透過して来るレーザ出力を変調させることができるのである。

ところで、上記のようにして変調して得られる透過レーザ光と入外レーザ光とはその陽光方向を現にしたものである。そのため、第1図のレーザ出力変調装置5からの透過レーザ光9を円隔光に変換してレーザ加工する場合、1/4波長板15の回転角を透過レーザ光9の偏光方向に応じて調整しなければならない、次に説明する。

第4図において入射角のの入射光Aと矩折角との透過光Dとの間にフレネルの公式を適用すると、

$$Ds = 2 \sin x \cdot \cos \theta \cdot As$$

$$\text{sin} (\theta + \chi) \qquad \cdots (8)$$

 $D p = 2 \sin \chi \cdot \cos \theta \cdot A p$

Ds / Dp = cos (θ-x)・As / Ap ··· (w) 今、入射光の電場ベクトルの入射面とのなす角をαi とし、返過光の電場ベクトルの入射面とのなす角をαt とすると、(w) 式は、

tan α l = cos $(\theta - \chi)$ · tan α i ... (11) ξ & ξ .

ここで、プリュスタ角でレーザ光が入射されるので、人射角 0 と屈折角 x との間には常に次の切式の関係が成り立つ。

 $\theta + \chi = 9 0$

さらに Z n S e の 場合、上記のように θ = 6 7 . 38° で めるから、屈折角 x = 2 2 . 6 2° となる。 従って、式 m) は改めて、

 $tan \alpha t = cos (67,38 ^ - 22.62 ^) tan \alpha i$ = 0.71 • tan \alpha i ... as

式のを基にして類出した入射光の電場ベクトルAと入射面のなす角αiに対する透過光の電場ベクトルクトルDと入射面のなす角αtの関係が第8図に点線で示されている。そこで、例えば第9図のように入射レーザ光の温光方向Aがブリュスタウィ

たように 1 / 4 被長板 2 7 を 9 . 6 2 * だけ回転 させて常に 円偏光となるよう補正を加えてやる必要がある。 ところが、第 1 図にこのの理を 長板 2 7 を 用いた 場合には、方位角を 常に 4 5 * とを する 2 7 を 用いた 場合には、方位角を 常に 4 5 * とする 2 には 1 / 4 波長板を主反射銀1 3 の位置に おいて 2 触のまわりに 四転 させなければならなくなる 4 合も出てくる。

そこで第1図に示したように主反射観13の直下方に1/4被長板15を設けて、C軸方向に回転できる構造とし、1/4被長板15へ入別する直線偏光のレーザ光9の方位角が常に45、となるように制御することにより円偏光を形成するようにしているのである。

次に、上記構成のレーザ出力変調装置を用いたレーザ出力変調方法の具体例を説明する。

入別レーザ光3の福光方向は入射面1P」に対して常にα-45°の方位角を持つものとし、ブリュスタウィンドウ7の設置角βを2機間りの回

ンドウBWの人射面 i Pに対して方位的 α i = 3 0 ' のとき、透過光の 偏光方向 D は方位的 α t = 2 2 . 3 ' となる。また第 8 図から方位的 α i = 4 5 ' のときにα t = 3 5 . 3 8 ' , α i = 2 5 ' のときにα t = 1 8 . 3 2 ' となる。

以上のようにして称られる透過レーザ光から円 幅光を形成するには、第10回に示すように直線 偏光のレーザ光9を方位角45、方向で入別の4 5、で1/4波長板27に入別させる。

転により変化させる場合を考慮する。

i) β = 0 ° の場合

第12図に示すように、ブリュスタウィンドウの設置角度を入射面に対してゼロとなるように設置すると、第8図のグラフから透過光9は入射面に対して方位角αに一35、38°で伝搬して外で、そこで、前方に位相シフトの少ない金回反射 頂13を設置し、反射させて伝搬させる。その下方の1/4 波長板15への入射状態は、方位角α

しかし、前にも述べたように、この1/4 放長板15への入射状態は方位角45°で入別させなければならない。そこで、C軸を上から見て反時計方向に9.62°回転させなければならない。

第13図は1/4波長板15への入射状態と、 その補正の様子を示し、扇図(a)は補正前で、 (b)は補正後である。

ii) β = 70°の場合

ブリュスタウィンドウ 7 の方位角 B を第 1 4 図 のようにセットすると、ブリュスタウィンドウ 7

の入射面 I P と偏光方向とのなす β α i は 2 5 ° となる。

そこで 第8図のグラフから、透過光9の偏光方向とブリュスタウィンドウ 7の入射面 IPとのなり角々 t = 18.32 ** となる。さらに、この透過光9は主反射統13に伝搬されるが、この主反射統13の入射面が初めの入射光3の入射面と同一であるため、この主反射統13への透過光の偏光方向は第15回に示すように、αt ** = 90 ** - (18.32 ** + 20 **) = 51.68 ** となる。

そして、1/4数長板15への人射状態は第1 6図に示すようになる。

2図はZn Se ブリュスタウィンドウにおける光 反射過度の入射角に対する関係を示すグラフ、第 3 図はブリュスタウィンドウの透過光のP. S 成 分分布を示す概念図、第4図は光の反射と屈折の 関係を示す図、第5図は入射光のベクトル分解図、 第6回はアリュスタウィンドウに対する方位角と 透過率との関係を示すグラフ、第7回は透過光の 偏光状態を示す概念図、第8回はプリュスタウィ ンドウの入射光と透過光の方位角の変化を示すグ ラフ、第9図はブリュスタウィンドウに対する光 の透過特性を示す概念図、第10図は1ノ4波及 板に対する光の反射特性を示す概念図、第11図 はこの発明方法の一実施例を示す概念図、第12 図は上記装置発明の実施例の作用を示す概念図、 第13図は間実施例の1/4波長板の角度調整の 一例を示す平面図、第14図は同上装置発明の実 施例のプリュスタウィンドウ邸の作用を示す概念 図、第15図は周上実施例の主反射銃部分の作用 を示す正面図、第16図は同上実施例の1/4波 長 板 部 の 作用 を 示 す 平 面 図 、 第 1 7 図 は 間 上 実 施

わり、α < 4.5° のとき上から見てなまわりに必要角度の回転を施せばよいことになる。

尚、上記実施例の装留では主反射級13を川いて光軸2に対してC軸を垂直方向に屈折させているが、この実施例に限定されることはない。例えば、光軸2とC軸とを一致させるように第1図における円偏光装置17全体を主反射級13の位置に設置してもよい。

〔発明の効果〕

この発明は、ブリュスタウィンドウを入射光報を中心にして回転自在とし、 直線幅光のレーザ光をブリュスタウィ 透過レーザ光の強度を変調器と である。 従って、レーザ発 機器の からのレーザ出力は常時一定に保ちながらも、 強の のができ、 所望強度のレーザを安定して 得られる利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明装置の一実施例の正面図、第

例の 1 / 4 被長板の角度調整の一例を示す平面図である。

1 … レーザ発振器 3 … レーザ光

5 … レーザ出力変調装置

7 -- アリュスタウィンドウ

9 … 透過レーザ光 13 … 主反射鎖

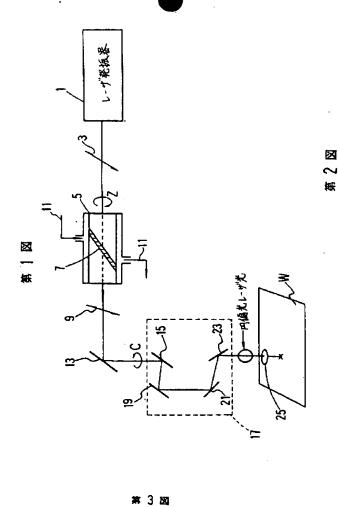
15 … 1 / 4 被 長板 1 7 … 円 偏 光 装置

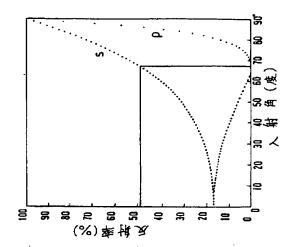
19, 21, 23…反射統

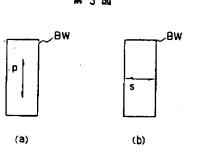
2 5 ··· 集光レンズ W ··· ワーク

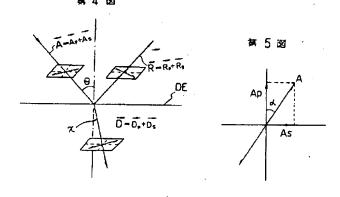
代理人 弁理士 三 好 保

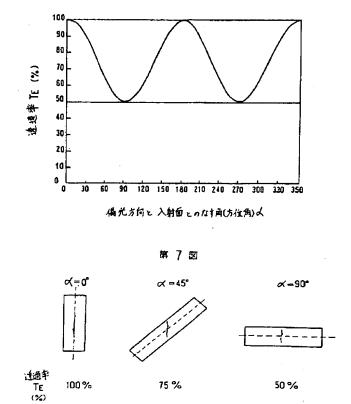










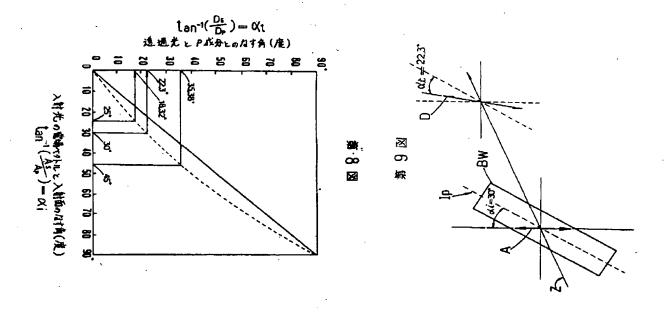


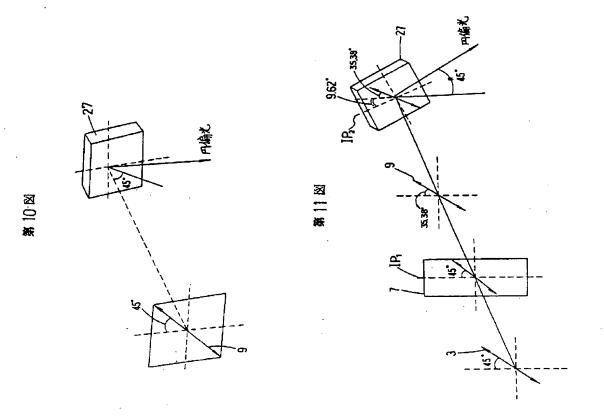
75 %

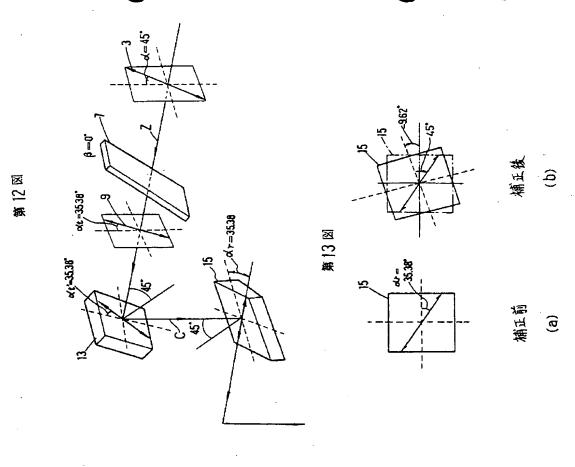
50%

第6図

100%







第14 図

